








	<p>SI4100DY-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4100DY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 6.8A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4100DY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 105428 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4100DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 6.8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	105428 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	63 mOhm @ 4.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	600pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

SI4100DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4100DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4100DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4100DY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI4100DY VISHAY SI4100DY VISHAY	 SI4100BDDY-T1-GE3 Vishay Precision Group SI4100BDDY-T1-GE3 VISHAY/	 SI4100DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 6.8A 8-SOIC	 SI4100DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 6.8A 8-SOIC
 SI4101DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 25.7A 8SOIC	 SI4100DY-T1 VISHAY VISHAY SO-8	 SI410 Vishay Precision Group SI410 VISHAY	 SI4101DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 25.7A 8SOIC

heiße Teile

Mehr

 SI4004DY-T1-E3	 SI4010-C2-GSR	 SI4010-C2-GSR.	 SI4010-C2-GT	 SI4010DY
 SI4010DY-T1-GE3	 SI4010DY-T1-GE3	 SI4012-C1001GTR	 SI4021-A1-FTR	 SI4022-A0-FTR
 SI4022-A1-FTR	 SI4030-A0-FM	 SI4032-V2-FMR	 SI4033-B2-FM	 SI4048DY-T1-E3
 SI4056DY	 SI4056DY-T1-E3	 SI4056SPG	 SI4058DY	 SI4090DY
 SI4100BDDY-T1-GE3	 SI4100DY	 SI4100DY-T1-E3	 SI4100DY-T1-GE3	 SI4100DY-T1-GE3
 SI4102DY	 SI4102DY-T1-E3	 SI4102DY-T1-E3	 SI4102DY-T1-GE3	 SI4102DY-T1-GE3
 SI4104DY-T1-GE3	 SI4104DY-T1-GE3	 SI4108DY-T1-GE3	 SI4108DY-T1-GE3	 SI4110DY-T1-GE3
 SI4110DY-T1-GE3	 SI4112-D-GM	 SI4113-BMR	 SI4114DY	 SI4114DY-T1-E3
 SI4114DY-T1-E3	 SI4114DY-T1-GE3	 SI4114DY-T1-GE3	 SI4116DY	 SI4116DY-T1-E3
 SI4116DY-T1-E3	 SI4116DY-T1-GE3	 SI4116DY-T1-GE3	 SI4122-BTR	 SI4122-D-GMR

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited